カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



GRADE

Α

MESC TECHNICAL NEWS

No. M16C-33-9907

M16C/62、M16C/6N フラッシュメモリ版 ヒステリシスに関する注意事項

1. 対象品種

フラッシュメモリ 5V 版: M30624FGFP、M30624FGGP、M30625FGGP

M306N0FGTFP

フラッシュメモリ 3V 版: M30624FGLFP、M30624FGLGP、M30625FGLGP

2. 注意事項

P7₀/TxD₂/SDA/TA0_{0UT} 端子および P7₁/RxD₂/SCL/TA0_{IN}/TB5_{IN} 端子のヒステリシス幅は、規格値を満たしていません。

この注意事項は、上記に示すフラッシュメモリ版のみの問題です。

3. 対策

対象端子についてはノイズキャンセラを有していますので、表1に示す値以下のノイズであれば、除去します。不都合が生じる場合は、基板上での対応をお願いします。

表 1. P7₀、P7₁のノイズキャンセラ幅の実測値

P70、P71の モード設定	5V版 (VCC=5V時)	3V版 (VCC=3V時)
IICモード時	64ns	58ns
IICモード以外時	10ns	20ns